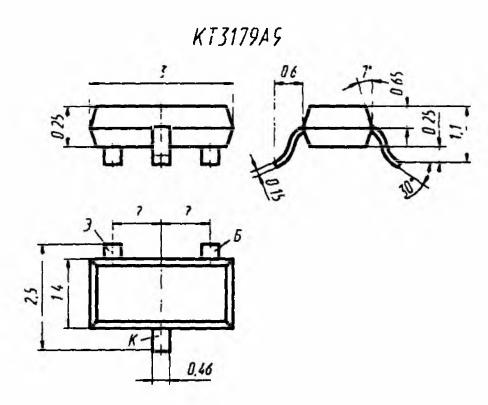
KT3179A9

Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный структуры п-р-п универсальный. Предназначен для применения в бытовой видеотехнике в составе гибридных интегральных микросхем, в платах поверхностного монтажа. Выпускается в пластмассовом корпусе с жесткими выводами. Тип прибора указывается в этикетке.

Масса транзистора не более 0,01 г.

Изготовитель — акционерное общество открытого типа «Элекс», г. Александров.



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{\rm KB} = 5$ В, $I_{\rm K} = 10$ мА, не менее:

	T = +25 u +85	5 °C	65
	$T = -60 ^{\circ}\text{C} \dots$		10
_		11 400 B	

Обратный тож коллектора при U_{KB} = 100 B, не более:

$T = -60 \text{ H} + 25 \text{ C} \dots$	1 MKA
T = +85 °C	10 mkA

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—база	150 B
Постоянное напряжение коллектор—эмиттер	150 B
Постоянное напряжение эмиттер-база	5 B

Постоянный ток коллектора при $T = +25$ °C	55 mA
Постоянная рассеиваемая мощность коллек-	
тора¹ при <i>T</i> = -60+25 °C	0,2 Bt
Температура р-л перехода	+125 °C
Тепловое сопротивление переход — среда	
Температура окружающей среды	-60+85 °C

При T = +25...+85 °C максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора рассчитывается по формуле

$$P_{\rm K~MAKC} = (125 - T)/500$$
, Bt.

Допустимое значение статического потенциала 500 В.

Очистку транзисторов, используемых для автоматической сборки, рекомендуется производить в спирто-бензиновой смеси (1:1) при виброотмывке с частотой 50 Гц и амплитудой колебаний до 1 мм в течение 4 мин.

Транзистор изготавливают с отформованными выводами, перед монтажом дополнительной подготовки не требуется.

Пайку выводов рекомендуется проводить в следующих режимах: одноразовым погружением корпуса в расплавленный припой при температуре не выше +265 °C не более 4 с. Припой ПОС-61 по ГОСТ 21930, флюс состоит из 25% по массе канифоли (ГОСТ 19113) и 75% по массе изопропилового (ГОСТ 9805) или этилового (ГОСТ 18300) спирта, сплавление паяльной (лудящей) пастой в режиме: нагрев вывода в месте пайки до температуры не выше +190 °C, не более 30 с, последующий нагрев вывода в месте пайки до температуры не выше +230 °C в течение не более 15 с.

При включении транзистора в электрическую цель, находящуюся под напряжением, базовый вывод необходимо присоединять первым и отключать последним. Работа транзистора в режиме «оборванной базы» по постоянному току категорически запрещается.